

## О ВЛИЯНИИ НЕСОИЗМЕРИМЫХ МОДУЛЯЦИЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НА СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

*В.П.Минеев*

*Институт теоретической физики им.Л.Д.Ландау  
142432 Черноголовка, Московская обл., Россия*

*Centre d'Etudes Nucleaires de Grenoble DRFMS/SPSMS  
85X-38041 Grenoble Cedex 24 France*

Поступила в редакцию 27 апреля 1993 г.

Рассмотрены изменения макроскопической симметрии кристалла, в частности, симметрии сверхпроводящих фаз с многокомпонентным параметром порядка в тяжелофермионном сверхпроводнике  $UPt_3$ , вызванные структурной модуляцией, несоизмеримой с периодами исходной кристаллической решетки.

Причина расщепления сверхпроводящего фазового перехода в  $UPt_3$  – одна из главных загадок физики металлов с тяжелыми фермионами [1]. Очередная попытка ее разрешения предпринята в недавних экспериментах по электронной микроскопии  $UPt_3$  [2], в которых обнаружена модуляция кристаллической решетки, несоизмеримая с периодами кристаллической структуры этого соединения. Установлено, что хорошо отожженные образцы, где имеется расщепление сверхпроводящего перехода, состоят из однородных доменов с определенной несоизмеримой структурой размером  $\sim 10^4 \text{ \AA}$ . В то же время в неотожженных монокристаллах  $UPt_3$ , где расщепления перехода не наблюдается, размер таких доменов лишь несколько превышает сверхпроводящую длину когерентности  $\xi_0 \approx 120 \text{ \AA}$ . Так как в неотожженных кристаллах исчезает не только расщепление перехода, но и сглаживается скачок теплоемкости, эти наблюдения скорее свидетельствуют о своеобразном неоднородном размытии сверхпроводящего перехода на некоторый интервал температур за счет уменьшения размеров доменов с определенной структурной модуляцией, чем о влиянии несоизмеримой модуляции на величину расщепления сверхпроводящего перехода.

Отсутствие прямых экспериментальных доказательств влияния несоизмеримости на расщепление сверхпроводящего перехода в  $UPt_3$  не снимает, разумеется, общего вопроса о возможных изменениях сверхпроводящего состояния в результате появления несоизмеримых кристаллических модуляций. Известно, что несоизмеримые модуляции кристаллической структуры могут изменять макроскопическую симметрию исходного кристалла [3]. Симметрия же сверхпроводящих фаз с нетривиальным спариванием определяется прежде всего макроскопической симметрией направлений кристалла [4]. Изменение последней из-за появления структурных модуляций эквивалентно включению внешнего поля, нарушающего симметрию сверхпроводящего состояния. В настоящей работе будут рассмотрены примеры такого рода симметричных изменений в кристаллическом классе  $D_{6h}$ , к которому относится  $UPt_3$ , и их влияние на сверхпроводимость. Подобные изменения гексагональной симметрии, возникающие в несоизмеримой фазе кварца, кратко перечислены в обзоре [5].

Пусть в кристалле имеется отклонение функции плотности  $\rho(\mathbf{r})$  от плотности  $\rho_0(\mathbf{r})$  невозмущенного кристалла, представляющее набор плоских волн:

$$\eta(\mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) - \rho_0(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n f_i(\mathbf{q}_i \mathbf{r} + \psi_i). \quad (1)$$

Здесь  $f_i(x)$  – периодические функции, которые для простоты мы будем считать синусоидами  $f_i(x) = \eta_i \cos(x)$ . Согласно работе [2] структурные модуляции в  $\text{URt}_3$  состоят из трех наборов волн: *A*-типа с волновыми векторами  $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$  такими, что  $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 = 0$ , *B*-типа с волновыми векторами  $\mathbf{q}_4, \mathbf{q}_5, \mathbf{q}_6$ , также  $\mathbf{q}_4 + \mathbf{q}_5 + \mathbf{q}_6 = 0$  и *C*-типа с волновым вектором  $\mathbf{q}_7$ . Таким образом, имеется 7 волн с разными направлениями длин и амплитудами. Векторы  $\mathbf{q}_i$  не лежат в плоскости  $(x, y)$ , ортогональной гексагональной оси  $z$  так, что модуляция  $\eta(\mathbf{r})$  локально создает триклинные искажения гексагональной решетки. Оказывается, что триклинные искажения сохраняются и в макроскопической симметрии направлений гексагонального кристалла со структурной модуляцией описанного типа.

Чтобы убедиться в этом необходимо рассмотреть взаимодействие модуляций плотности с деформациями кристалла. Мы ограничимся при этом только орторомбическими деформациями, важными для приложений к сверхпроводимости. С этой целью подставим (1) в инвариант:

$$(u_{xx} - u_{yy}) \left[ \left( \frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 - \left( \frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \right] + 4u_{xy} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y}, \quad (2)$$

где  $u_{ik}$  – компоненты тензора деформаций. После усреднения по объему с размером, большим по сравнению с периодами пространственной модуляции  $\frac{2\pi}{q_i}$  получим

$$\sum_{i=1}^n q_i^2 \eta_i^2 \{ (\cos^2(\hat{q}_i \hat{x}) - \cos^2(\hat{q}_i \hat{y})) (u_{xx} - u_{yy}) + 4 \cos(\hat{q}_i \hat{x}) \sin(\hat{q}_i \hat{y}) u_{xy} \}. \quad (3)$$

Минимизация суммы этого выражения и энергии упругой деформации, квадратичной по тензору деформаций  $u_{ik}$ , даст независимые от координат равновесные значения компонент  $(u_{xx} - u_{yy})$ ,  $u_{xy}$ , появляющиеся в присутствии волн структурной модуляции. Разумеется, если векторы  $\mathbf{q}_i$  не лежат в плоскости  $(x, y)$ , то в дополнение к (2) надо выписать также все остальные инвариантные комбинации, билинейные по  $u_{ik}$  и  $\frac{\partial \eta}{\partial r_i}, \frac{\partial \eta}{\partial r_k}$ , что даст равновесные значения остальных компонент  $u_{ik}$ .

Величины  $u_{xx} - u_{yy}$ ,  $u_{xy}$  задают тензор орторомбических деформаций

$$\epsilon_{ik} = \begin{pmatrix} u_{xx} & u_{xy} \\ u_{xy} & -u_{yy} \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Орторомбические деформации, коль скоро они есть в гексагональном кристалле, приводят к расщеплению сверхпроводящего перехода в состояние, относящееся к любому из двух двумерных представлений  $E_1, E_2$  гексагональной группы симметрии [6,7]. В этом случае функционал Гинзбурга–Ландау, описывающий сверхпроводящий переход имеет вид:

$$F = \alpha_0(T - T_{c0})|\bar{\psi}|^2 + \beta_1|\bar{\psi}|^4 + \beta_2|\bar{\psi}\bar{\psi}|^2 + b\epsilon_{ik}(\psi_i\psi_k^* + \text{к.с.}). \quad (5)$$

При  $\beta_2 > 0$ ,  $b > 0$  сначала при  $T_{c1} = T_{c0} + \frac{bu_{yy}}{\alpha_0}$  происходит переход в фазу  $\psi \sim (0, 1)$ , затем при более низкой температуре  $T_{c2} < T_{c1}$  переход в фазу  $\psi \sim \left(ia \frac{T-T_{c2}}{T_{c2}}, 1\right)$ .

Другой тип изменения макроскопической симметрии может быть найден из взаимодействия модуляций плотности и поляризации кристалла<sup>1)</sup>  $P_z$  вдоль оси  $\hat{z}$ :

$$P_z \eta \left( \frac{\partial^3 \eta}{\partial y^3} - 3 \frac{\partial^3 \eta}{\partial y \partial x^2} \right) \left( \frac{\partial^3 \eta}{\partial x^3} - 3 \frac{\partial^3 \eta}{\partial x \partial y^2} \right). \quad (6)$$

После подстановки (1) в (6) и выполнения усреднения получим вклад от тройки волн А-типа:

$$P_z \eta_1 \eta_2 \eta_3 \cos(\psi_1 + \psi_2 + \psi_3) [q_2^3 q_3^3 \sin^3 \theta_2 \sin^3 \theta_3 \sin 3\varphi_2 \sin 3\varphi_3 + (1 \leftrightarrow 2) + (3 \leftrightarrow 1)], \quad (7)$$

где  $\theta_i$ ,  $\varphi_i$  – соответственно полярный и азимутальный углы вектора  $q_i$ . Вклад от тройки волн В-типа имеет аналогичный вид.

Взаимодействие структурной модуляции и поляризации  $P_z$ , линейное по  $P_z$ , приводит к нарушению пространственной четности – появлению в кристалле выделенного направления вдоль оси  $z$ . Вследствие этого в функционале Гинзбурга–Ландау для двухкомпонентной сверхпроводящей фазы появляется инвариант Лифшица:

$$\psi_1 \frac{\partial \psi_2^*}{\partial z} - \psi_2^* \frac{\partial \psi_1}{\partial z} + \text{к.с.}, \quad (8)$$

который, разумеется, надо рассматривать совместно с обычными градиентными членами второго порядка:

$$F = \alpha_0 (T - T_{c0}) |\vec{\psi}|^2 + \beta_1 |\vec{\psi}|^4 + \beta_2 |\vec{\psi} \vec{\psi}|^2 + c \left( \psi_1 \frac{\partial \psi_2^*}{\partial z} - \psi_2^* \frac{\partial \psi_1}{\partial z} + \text{к.с.} \right) + K \frac{\partial \vec{\psi}}{\partial z} \frac{\partial \vec{\psi}^*}{\partial z}. \quad (9)$$

Функционал (9) записан в пренебрежении орторомбическими искажениями (5). Такой функционал описывает фазовый переход в сверхпроводящую холестерическую фазу

$$\vec{\psi} = \psi_0 e^{i\varphi - i\theta(z)} (1, i), \quad \beta_2 > 0 \quad (10)$$

$$\vec{\psi} = \psi_0 e^{i\varphi} (\cos \theta(z) \sin \theta(z), \quad \beta_2 < 0. \quad (11)$$

Здесь  $\theta(z) = \kappa z$ ,  $\kappa = -\frac{\epsilon}{K}$ ,  $T_c = T_{c0} + \frac{2c^2}{\alpha_0 K}$ . В случае  $\beta_2 < 0$  члены шестого порядка  $\delta(|\psi_1|^6 - 15|\psi_1|^4|\psi_2|^2 + 15|\psi_1|^2|\psi_2|^4 - |\psi_2|^6)$  фиксируют при низких температурах фазу холестерической спирали  $\theta(z) = \frac{\pi}{6}$  при  $\delta > 0$ ; и  $\theta = 0$  при  $\delta < 0$ .

В заключение еще раз подчеркнем, что появление несоизмеримых структурных модуляций в кристалле гексагональной симметрии неизбежно создает орторомбические искажения и нарушает пространственную четность кристалла. Хотя величина этих эффектов может оказаться весьма малой, но для сверхпроводника с многокомпонентным параметром порядка, каковым возможно является  $UPt_3$ , орторомбичность должна приводить к расщеплению фазового перехода в сверхпроводящее состояние, а отсутствие центра инверсии – к появлению холестерических (геликоидальных) сверхпроводящих фаз.

<sup>1)</sup> В случае кварца [5], где пространственная модуляция сама обладает симметрией третьего порядка вокруг оси  $\hat{z}$  достаточно рассмотреть взаимодействие вида  $P_z \eta^2 \left( \frac{\partial^3 \eta}{\partial y^3} - 3 \frac{\partial^3 \eta}{\partial y \partial x^2} \right)$ .

Настоящая работа была выполнена в Центре ядерных исследований Гренобля, где автор работал в рамках соглашения о сотрудничестве между ИТФ им.Л.Д.Ландау и Высшей Нормальной Школой (ENS). Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность Э.Брезэну (E.Brezin) и Ж.Флуке (J.Flouquet) за всестороннюю помощь и поддержку. Я также признателен В.Плахтию за обсуждение различных кристаллографических вопросов, Г.Воловику, Л.Левитову, Л.Фальковскому, А.Дюгаеву и другим участникам семинара ИТФ им.Л.Д.Ландау за активный интерес к работе.

- 
1. L.Taillefer, J.Flouquet, and G.G.Lonzarich, *Physica B* **169**, 257 (1991).
  2. P.A.Midgley, S.M.Hayden, L.Taillefer, et al., *Phys. Rev. Lett.* **70**, 678 (1993).
  3. V.Dvorak, V.Janovec, and Y.Ishibashi, *Journ. Phys. Soc. Jap.* **52**, 2053 (1983).
  4. Г.Е.Воловик, Л.П.Горьков, *ЖЭТФ* **88**, 1412 (1985).
  5. G.Dolino, In: *Incommensurate phases in Dielectrics*, v.2, ed. by R.Bline and A.P.Levanyuk, Elsevier Science Publishers B.V., 1986, p.205.
  6. D.W.Hess, T.Tokoyasu, and J.A.Sauls, *J. Phys. Cond. Matter* **1**, 8135 (1989).
  7. K.Machida, M.Ozaki, and T.Ohmi, *J. Phys. Soc. Jap.* **58**, 2244 (1989); **58**, 4116 (1989).